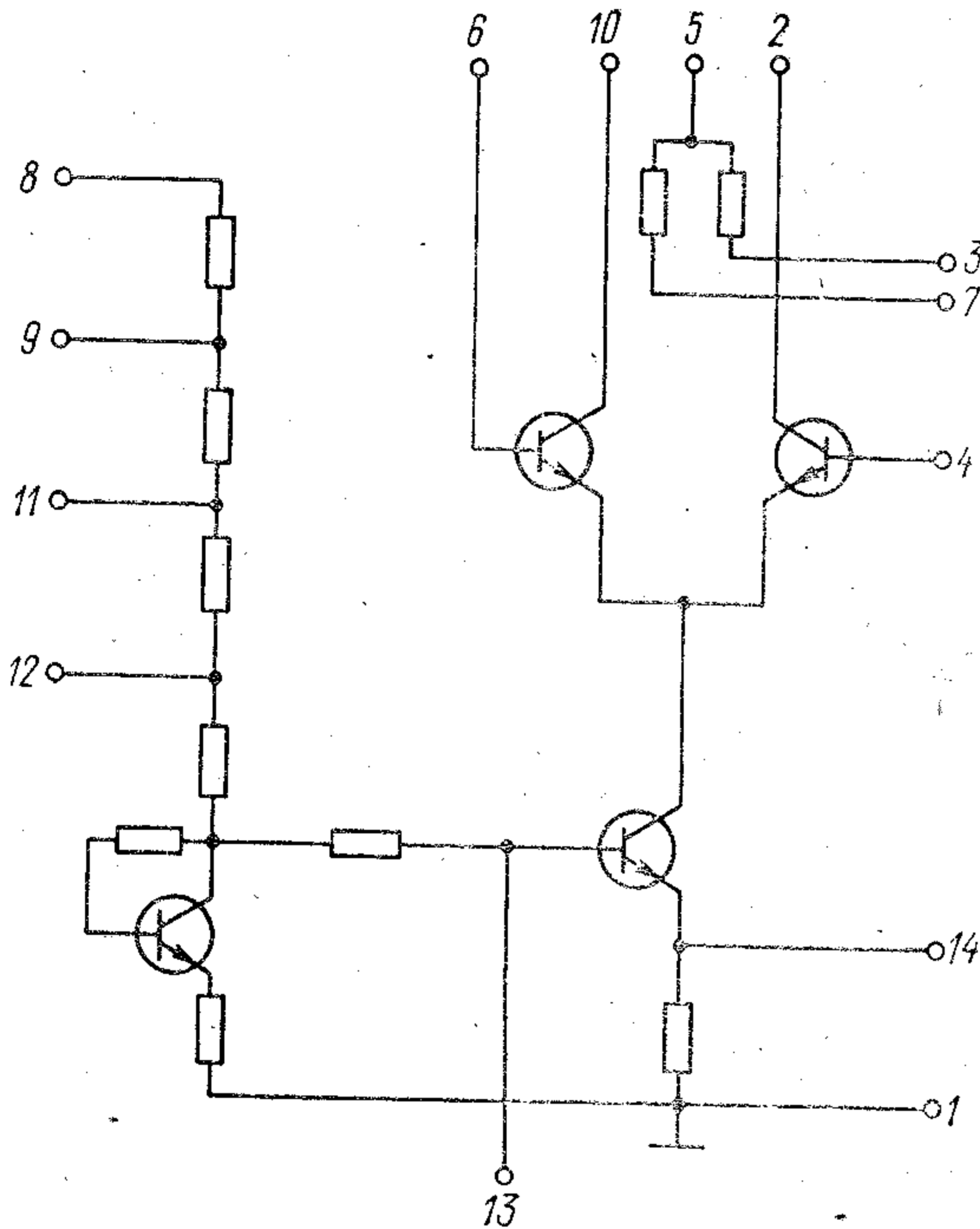


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



- 1 — ЗЕМЛЯ
- 2 — ВЫХОД
- 3 — ВЫВОД
- 4 — ВХОД
- 5 — ВЫВОД
- 6 — ВХОД
- 7 — ВЫВОД
- 8 — +6 В
- 9 — ВЫВОД
- 10 — ВЫХОД
- 11, 12 — ВЫВОДЫ
- 13 — ВХОД
- 14 — ВЫВОД

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 10^\circ\text{C}$ )

Напряжение питания, В . . . . .	$6 \pm 10\%$
Ток потребления, мА . . . . .	от 1,8 до 3
Напряжение, В:	
на выводе 9 . . . . .	от 3,6 до 4,4
»  »  11 . . . . .	от 2,1 до 2,8
»  »  12 . . . . .	от 1,4 до 1,8
»  »  13 . . . . .	от 1,0 до 1,4
Крутизна преобразования, мА/В, не менее . . . . .	10
Выходное напряжение покоя, В . . . . .	от минус 0,2 до +0,2
Верхняя граничная частота по уровню 6 дБ, МГц, не менее . . . . .	150

Коэффициент шума при $f_{вх}=100$ МГц, дБ, не более . . . . .	8
Глубина регулировки усиления, дБ, не менее . . . . .	60
Двухсигнальный клирфактор, дБ, не менее . . . . .	70

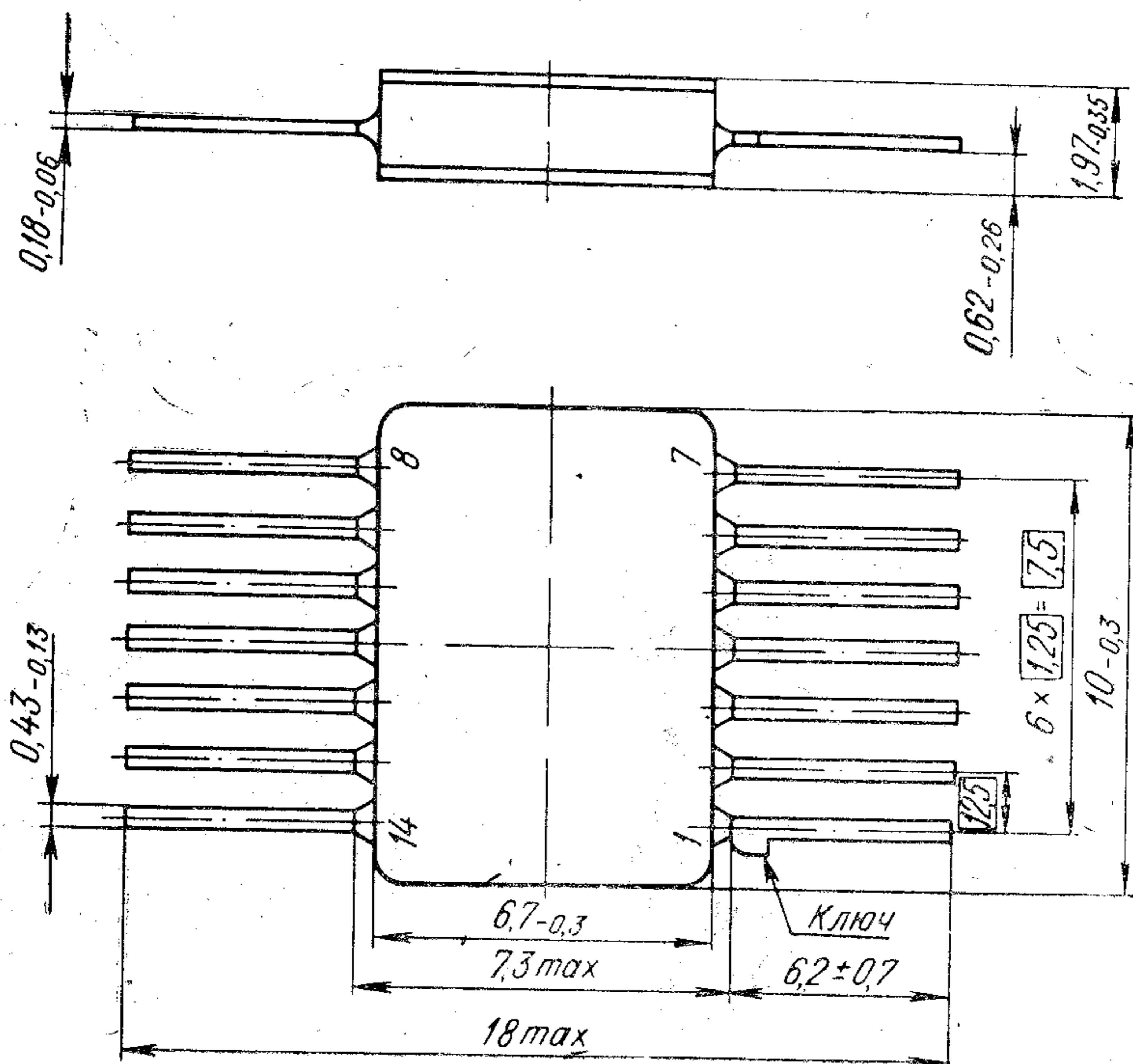
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение питания, В . . . . .	9
Максимальная рабочая частота, МГц . . . . .	150
Максимальная амплитуда входного напряжения на выводе 13, В . . . . .	1,2

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 175

## Общие данные

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ



Масса не более 1 г

### ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц . . . . . от 1 до 5000  
 амплитуда ускорения,  $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$  (g) . . . . . 400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение,  $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$  (g) . . . . . 15 000 (1500)  
 длительность действия ударного ускорения, мс. . . . . от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение,  $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$  (g) . . . . . 1500 (150)  
 длительность действия ударного ускорения, мс . . . . . от 1 до 5

Линейные нагрузки,  $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$  (g) . . . . . 5000 (500)

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 175

## Общие данные

Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па)	$10^{-6}$ ( $1,3 \cdot 10^{-4}$ )
Атмосферное повышенное давление, атм . . . . .	3
Повышенная температура среды, °С:	
для микросхемы 175ПК1 . . . . .	100
» остальных микросхем . . . . .	125
Пониженная температура среды, °С . . . . .	минус 60
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

## НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная паработка <sup>О</sup> , ч . . . . .	50 000
Срок сохраняемости <sup>О</sup> , лет . . . . .	25

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «питание» и «земля») к корпусу и выходам микросхем, не используемым согласно принципиальной схеме.

Допускается непосредственное каскадирование микросхем через разделительный конденсатор.

Величины блокировочных и разделительных конденсаторов при эксплуатации могут отличаться от приведенных в ТУ. Для микросхем типа 175УВ3 допускается устанавливать резистор между выводами 6 и 8 в пределах 0,1—100 кОм.

Допускается установка и крепление микросхем к платам вплотную или с зазором до 0,7 мм с последующей прилакировкой (лак ЭП-730 ГОСТ 20824—81) или приклейкой клеем АК-20.

Допустимое значение статического потенциала 200 В.

<sup>О</sup> В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.